

Diac

**4E50-8**

50V / 150mA

**DATASHEET**

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

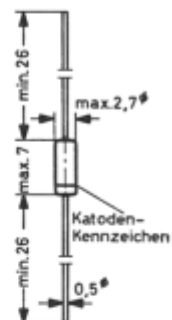
## 4 E 20-8...4 E 200-28

### Silizium-Vierschichtdioden

für Kippschaltungen, Impulsverstärker, Zählstufen usw.

Alle Typen sind auch in MIL-Ausführung lieferbar, Zusatz „M“ zur Typenbezeichnung.

Glasgehäuse JEDEC DO-7  
51 A 2 nach DIN 41 880  
Gewicht ca. 0,2 g  
Maße in mm



### Grenzwerte

Dauergleichstrom	$I_F$	150	mA
Impulsstrom 1)	$I_{FM}$	10	A
Verlustleistung bei $T_U < 50\text{ °C}$	$P_{tot}$	150	mW
Umgebungstemperatur	$T_U$	-40...+65	°C

### Kennwerte bei $T_U = 25\text{ °C}$

Typ	Schaltspannung $U_S$ V	Haltestrom $I_H$ mA
4 E 20-8	20 ± 4	1 ... 15
4 E 20-28	20 ± 4	14 ... 45
4 E 30-8	30 ± 4	1 ... 15
4 E 30-28	30 ± 4	14 ... 45
4 E 40-8	40 ± 4	1 ... 15
4 E 40-28	40 ± 4	14 ... 45
4 E 50-8	50 ± 4	1 ... 15
4 E 50-28	50 ± 4	14 ... 45
4 E 100-8	100 ± 10	1 ... 15
4 E 100-28	100 ± 10	14 ... 45
4 E 200-8	200 ± 20	1 ... 15
4 E 200-28	200 ± 20	14 ... 45

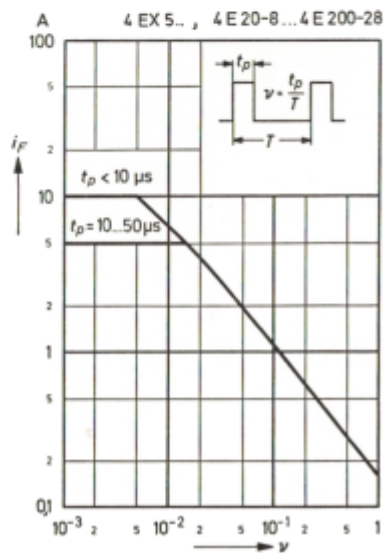
1) siehe Kurve auf der folgenden Seite

## 4 E 20-8...4 E 200-28

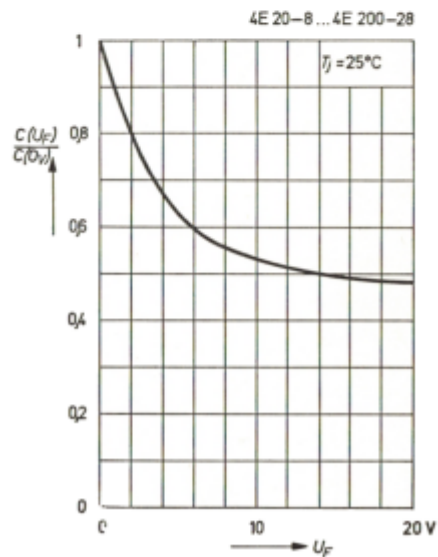
Schaltstrom	$I_S$	<125	$\mu\text{A}$
Haltespannung	$U_H$	0,5...1,2	V
Sperrstrom bei $0,75 U_S$	$I_D$	<15	$\mu\text{A}$
inverse Abbruchspannung	$U_{ab}$	$>0,75  U_S $	
differentieller Durchlaßwiderstand bei $I_F = 70 \text{ mA}$	$r_f$	<2	$\Omega$
Kapazität bei $U_R = 0, f = 10 \text{ kHz}$	$C$	$\frac{2000}{U_S(\text{V})}$	pF
Durchlaßspannung bei $I_F = 70 \text{ mA}$	$U_F$	<1,5	V
Einschaltzeit	$t_{on}$	0,1 <sup>1)</sup>	$\mu\text{s}$
Sperrverzug	$t_{rr}$	5 <sup>1)</sup>	$\mu\text{s}$
Wärmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft	$R_{thU}$	0,67	K/W

1) schaltungsabhängig

### zulässiger Impulsstrom in Abhängigkeit vom Tastverhältnis



### Kapazität in Abhängigkeit von der Spannung in Durchlaßrichtung



## 4 E 20-8... 4 E 200-28

Haltestrom in Abhängigkeit  
von der Sperrschichttemperatur

